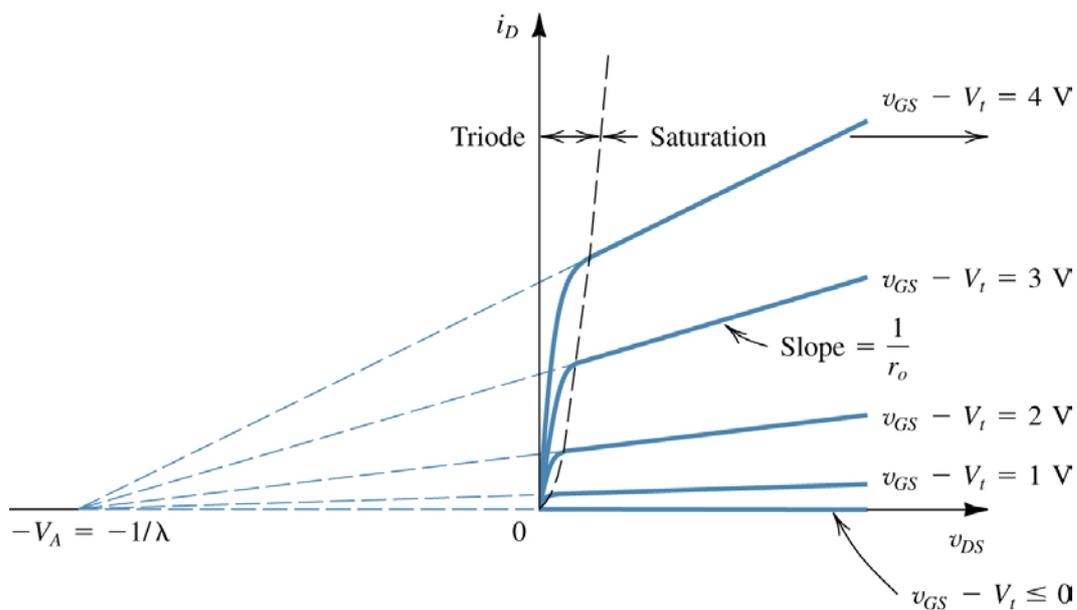


All'aumentare di  $V_{DS}$  oltre il valore di saturazione  $V_{DS\text{ SAT}}$  la posizione del *pinch-off* nel canale si allontana dal *drain*, determinando così la diminuzione della lunghezza effettiva del canale di una quantità  $\Delta L$ .



Variatione di  $I_D$  con  $V_{DS}$  nella regione di saturazione. Il parametro  $V_A$  del MOSFET è compreso generalmente nell'intervallo tra 30 V e 200 V.